#### BL-10C/2014G167

# SAXS and anomalous SAXS study on phase-separated structure induced by addition of iron bromide and the distribution of iron and bromine elements of polystyrene-*b*-poly (2-vinylpyridine) in THF solution

## Katsuhiro Yamamoto<sup>1,2</sup> and Shiho Kanie<sup>1</sup> <sup>1</sup>Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology <sup>2</sup>Frontier Research Institute for Materials Science, Nagoya Institute of Technology, Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya 466-8555, Japan

### 1 Introduction

ブロック共重合体は偏斥力や体積分率に応じて 様々なモルフォロジーを形成する。また、どちらか 一方の成分に選択的に相互作用する添加物を加える ことで、モルフォロジー転移あるいはその制御が可 能である。特に金属を導入して形成される相分離構 造(周期構造を有する)はリソグラフィー、記録媒 体などの機能性材料としての応用が期待されている。 過去の研究において、ポリスチレン (PS) とポリ (2-ビニルピリジン) (P2VP) から成るジブロック共重合 体 (S2VP) /THF 溶液(相溶状態)に塩化鉄 (III) を添 加すると、P2VP の窒素原子と鉄イオンが配位結合 を形成し、ミクロ相分離構造形成が誘起されること を見出した。さらに、塩化鉄(III)の添加量に応じて 球構造からシリンダー構造へのモルフォロジー転移 が確認された。これは配位結合による架橋によって 偏斥力が大きくなり、さらに鉄イオンの静電反発に よって P2VP の体積が増加し転移に至ったと考えら れる。このモルフォロジー転移のメカニズムを解明 するためには、金属塩の分布状態を調べる必要があ ると考え、本研究では、金属塩の両イオンの分布状 態を観察するために臭化鉄 (III) を用いて、ポリマー ドメイン中に、鉄および臭素原子がどのように分布 しているかを調査することを目的とした。

#### 2 Experiment

分子量分布の異なる S2VP を高真空下リビングア ニオン重合により二種類を合成した(S2VP B: Mn=  $7.85 \times 10^4$ , PDI = 1.9, S2VP N  $f_{PS} = 0.807$ vol%,  $M_n = 4.23$ ×10<sup>4</sup>, PDI = 1.15, f<sub>PS</sub> = 0.730 vol%)。分布の広い試料 は P2VP 鎖の分子量分布が狭く、PS 部分の分布が広 い試料である。S2VP と臭化鉄 (III) を共通溶媒であ るテトラヒドロフラン (THF) にそれぞれ溶解させ、 臭化鉄(III)/THF 溶液を S2VP/THF 溶液に滴下するこ とによってポリマー濃度 10wt.%、溶液中の Fe3+と 2VP の化学量論比 X=0.2 および 0.9 の溶液を調製し た。溶液の異常小角 X線散乱(ASAXS) 測定による構 造解析を行った。なお、X線エネルギーは鉄のK吸 収端(7.131keV)付近の7keV, 7.05keV, 7.09keV, 7.11keV, 7.13keV, 7.135keV と臭素の K 吸収端(13.483keV) 付近 D 13.2keV, 13.4keV, 13.44keV, 13.46keV, 13.48keV, 13.485keV で測定した。

#### 3 Results and Discussion

まず、鉄と臭素の吸収端から一番離れている 7keV で SAXS 測定を行った。Fig.1 に臭化鉄 (III) を添加し た S2VP\_B(X=0.9)溶液の散乱プロファイルを示す。 7keV では異常分散効果が小さく、電子密度差から P2VP/Fe 相の構造を観測できると考えられる。シリ ンダー構造の理論散乱と比較すると、半径が 16.2nm のシリンダー構造を形成していることが分かった。 X = 0.2 では球状モルフォロジーを形成することを確 認した。FeBr<sub>3</sub> 添加量によって球状構造からシリン ダー構造へと転移した。この転移メカニズムを考察 するため、各イオンの分布構造を明らかにすること を目指した。



Fig. 1: SAXS profile of S2VP including FeBr<sub>3</sub> (7keV) and the theoretical curve calculated for a hexagonally packed cylindrical structure

ASAXS 測定では、測定結果から特定元素の分布 した構造からの散乱を表す散乱関数 V2(q)を得るこ とができ、吸収端付近の最低三つエネルギーでの散 乱プロファイルから連立方程式によって求められる [1]。

ASAXS 測定から得られた鉄および臭素の吸収端 付近の一次元プロファイルをFig.2に示す。鉄の吸収 端付近の結果から、シリンダー状構造のParticle 散乱 (形状因子)のピーク部分を拡大して示す。この結 果、エネルギー変化による散乱強度の増減はほとん どみられなかった。これは、鉄イオンが P2VP 相に 均一に混ざり合っているために形状因子に与える因 子がなく、散乱強度に変化がなかったと考えられる。 次に臭素の吸収端付近の結果では、形状因子の散乱 ピークが臭素の吸収端に近づくにつれて散乱強度が 低下し、ピークが右にシフトしている。この変化の 原因は、吸収端に近づくにつれて臭素の寄与が小さ くなるため、見かけ上のドメインサイズが小さくな ったことが挙げられる。よって、臭素イオンの分布 状態が散乱プロファイルに影響を与えたと考えられ る。そこで、臭素の分布状態を表す散乱関数 V<sup>2</sup>(q)を 算出したところ Fig.3,4 の○で示す散乱プロファイル を得た。V<sup>2</sup>(q)は元の ASAXS 測定結果と比べて Particle 散乱ピークがはっきりとみられた。また、ピ ークが左にシフトしていることも確認できた。シリ ンダー構造の理論散乱と比較した結果をFig.4に示す とおり、臭素イオンはシリンダー領域に存在してい ることがわかった。しかし、半径が 18nm で計算し た結果が最も V<sup>2</sup>(q)に近いプロファイルであったこと から、P2VP/Fe 相が形成するシリンダー構造よりも 大きい領域であることが明らかになった。



Fig. 2: Energy dependent SAXS profiles of S2VP\_B including FeBr<sub>3</sub> near the absorption edge of Fe (upper) and the absorption edge of Br (lower).

以上のことから、鉄イオンは P2VP 相に均一に分 布しているのに対し、臭素イオンは P2VP/Fe 相が形 成するシリンダー構造よりも半径が大きいシリンダ 一領域に分布していることが明らかとなった。この 結果は、臭化鉄 (III) を添加した S2VP は高分子電解 質のような特徴を示しており、臭素イオンが対イオ ン凝集層を形成していることを示したと考えられる。 また鉄添加量が多くなるとドメイン内のプラス電荷 同士の静電反発によりドメインが大きくなることで シリンダー構造へと転移したと考えられる。



Fig.3: 1D-ASAXS profile of S2VP including FeBr<sub>3</sub> (13.2keV, 13.44keV, 13.48keV) and obtained  $V^2(q)$ from Br.



Fig.3:  $V^2(q)$  contributed from Br and the theoretical curve calculated for a cylindrical structure.

一方、分子量分布の狭い系(S2VP\_N)では,X =
0.2,0.9 においてもどちらも球状モルフォロジー
(BCC 格子上に配列)であった。だたし、鉄添加量

増加に伴い、球状ドメインの半径の増大を確認した。 球サイズの増大は静電反発によると考えられるが、 モルフォジー転移に至らなかった。この理由は分子 量分布が狭いことに起因する。相分離構造の分子量 分布依存性とは理論的[2]にも予測されておりその結 果と一致することが分かった。

References

- [1] I.Akiba et al. Macromolecules, 2012, 45, 6150-6157
- [2] D.M.Cooke et al. Macromolecules, 2006, 39, 6661-6671
- [3] M.W.Matsen et al. Macromolecules, 2011, 44, 6209-6219

\* yamamoto.katsuhiro@nitech.ac.jp